

鑫多晶-S2

GCL积极打造立体化的硅片业务发展模式，通过设备的创新化改造与自主研发、介入硅片辅料的规模化生产，致力提升光伏材料业务的整体竞争力。

GCL鑫多晶-S2高效多晶硅片能够为客户提供更高的效率，更加持久的表现，以及更低的成本。鑫多晶-S2是GCL通过对晶体生产理论的深刻理解，设计先进而独创的热场，开发精细的工艺，采用自产的优质硅料，在严格的质量控制下生产制造出来的全新产品，将助力电池、组件客户打造更具竞争力、更有价值的产品。



总体性能

- 较基准线有0.2-0.5%效率的提升
- 有效降低光伏发电成本LCOE
- 可以制备250+W多晶硅组件 (156mm×60片)

鑫多晶-S2 产品性能参数

材料特性 Material properties

特性 Property	规格 Specification
生长方式 Crystal Growth Method	DSS
导电型号/掺杂剂 Conductivity Type/Dopant	P/Boron
氧含量 Oxygen Concentration	$\leq 5.0 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$
碳含量 Carbon Concentration	$\leq 8.0 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$

电学特性 *Electrical properties*

电阻率 <i>Resistivity</i>	1.0~3.0 $\cdot cm$
少子寿命 <i>Brick Lifetime</i>	$\geq 5 \mu s$

几何尺寸 *Geometry*

厚度 <i>Thickness</i>	200±20, 180±18 μm	
TTV	$\leq 30 \mu m$	
翘曲度 <i>Warpage</i>	$\leq 50 \mu m$	
宽度 <i>Width</i>	156±0.5mm	
直角度 <i>Right Angle</i>	90°±0.3°	
对角线 <i>Diagonal</i>	219.2±0.5 mm	
倒角尺寸 <i>Chamfer Size</i>	斜边 <i>Hypotenuse</i>	0.5~2.0mm
	直角边 <i>Cathetus</i>	0.35-1.42mm
	斜角度 <i>Chamfer angle</i>	45°±10°
隐裂 <i>Microcrack</i>	无 <i>Not allowed</i>	
线痕 <i>Saw marks</i>	$\leq 10 \mu m$ &不限条数; 10~15 μm & ≤ 5 条/1cm	
崩边 <i>Edge Chip</i>	崩边深度 ≤ 0.3 mm, 长度 ≤ 0.5 mm; 最多2个/片 <i>Depth ≤ 0.3 mm ,Length ≤ 0.5 mm,Max 2 pieces/wafer</i>	
缺口 <i>Breakage</i>	无(V型) <i>Not allowed</i>	
微晶 <i>Micrograin</i>	单个微晶面积 $<3 \times 3mm^2$; 整个微晶区域面积 $<3 \times 3cm^2$ <i>Single Area$<3 \times 3mm^2$. Total Area$<3 \times 3cm^2$</i>	
孔洞 <i>Hole</i>	无 <i>Not allowed</i>	
表面品质 <i>Surface quality</i>	表面无损伤、无污点、无水渍、无污渍 <i>No surface damage, stains, water marks, or contamination allowed</i>	

关于 GCL

保利协鑫能源控股有限公司（恒生综合指数成分股：3800HK）是目前全球最大的太阳能光伏企业之一，是国内专业的大型清洁能源供应企业。保利协鑫致力于推动太阳能全球的普及应用，经过数年的开拓与发展，已成为全球领先的光伏材料供货商，全球最专业的光伏系统方案提供专家；并在全球范围内拥有多家大型光伏电站，拥有丰富的光伏电站运营管理经验。

联系 GCL

地址: 香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场17楼1703-1706室
中国苏州工业园区华池街时代广场苏州国际金融中心19楼
邮箱: gclpv_sales@gcl-power.com